

**4N22A**

**4N23A JAN, JANTX, JANTXV, SINGLE CHANNEL OPTOCOUPLEDERS**

**4N24A**

**Mii**

**OPTOELECTRONIC PRODUCTS  
DIVISION**

**Features:**

- Collector is electrically isolated from the case.
- Overall current gain...1.5 typical (4N24A)
- Base lead provided for conventional transistor biasing
- Rugged package
- High gain, high voltage transistor
- +1kV electrical isolation

**Applications:**

- Eliminate ground loops
- Level shifting
- Line receiver
- Switching power supplies
- Motor control

**DESCRIPTION**

Gallium Aluminum Arsenide (GaAlAs) infrared LED and a high gain N-P-N silicon phototransistor packaged in a hermetically sealed metal case. The **4N22A**, **4N23A** and **4N24A** can be tested to customer specifications, as well as to MIL-PRF-19500 JAN, JANS, JANTX, and JANTXV quality levels.

**\*ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS**

Input to Output Voltage .....	±1kV
Emitter-Collector Voltage .....	4V
Collector-Emitter Voltage .....	35V
Collector-Base Voltage .....	35V
Reverse Input Voltage .....	2V
Input Diode Continuous Forward Current at (or below) 65°C Free-Air Temperature (see note 1) .....	40mA
Peak Forward Input Current (Value applies for $t_w \leq 1\mu s$ , PRR < 300 pps) .....	1A
Continuous Collector Current .....	50mA
Continuous Transistor Power Dissipation at (or below) 25°C Free-Air Temperature (see Note 2) .....	300mW
Storage Temperature .....	-65°C to +125°C
Operating Free-Air Temperature Range .....	-55°C to +125°C
Lead Solder Temperature (1/16" (1.6mm) from case for 10 seconds) .....	240°C

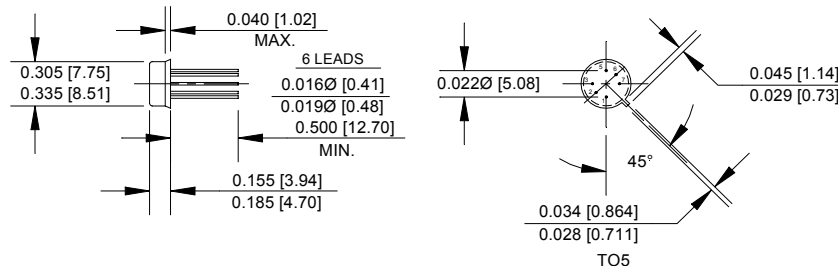
**Notes:**

1. Derate linearly to 125°C free-air temperature at the rate of 0.67 mA/°C above 65°C.
2. Derate linearly to 125°C free-air temperature at the rate of 5 mW/°C.

\* JEDEC registered data

**Package Dimensions**

**Schematic Diagram**



NOTE: ALL LINEAR DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS)

**\*ELECTRICAL CHARACTERISTICS INPUT LED**  $T_A = 25^\circ\text{C}$  Unless otherwise specified

PARAMETER	SYMBOL	MIN	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS	NOTE
Input Diode Static Reverse Current	$I_R$		100	$\mu\text{A}$	$V_R = 2\text{V}$	
Input Diode Static Forward Voltage	$V_F$	1	1.5	V	$I_F = 10\text{mA}$	
		0.8	1.3			
		0.7	1.2			

**\*OUTPUT TRANSISTOR**  $T_A = 25^\circ\text{C}$  Unless otherwise specified

PARAMETER	SYMBOL	MIN	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS	NOTE
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	35		V	$I_C = 100\mu\text{A}, I_B = 0, I_F = 0$	
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	35		V	$I_C = 1\text{mA}, I_B = 0, I_F = 0$	
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	4		V	$I_C = 0, I_E = 100\mu\text{A}, I_F = 0$	

**\*COUPLED CHARACTERISTICS**  $T_A = 25^\circ\text{C}$  Unless otherwise specified

PARAMETER	SYMBOL	MIN	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS	NOTE
On State Collector Current	$I_{C(ON)}$	0.15		mA	$V_{CE} = 5\text{V}, I_B = 0, I_F = 2\text{mA}$	
		0.2				
		0.4				
On State Collector Current	$I_{C(ON)}$	2.5		mA	$V_{CE} = 5\text{V}, I_B = 0, I_F = 10\text{mA}$	
		6				
		10				
On State Collector Current	$I_{C(ON)}$	1		mA	$V_{CE} = 5\text{V}, I_B = 0, I_F = 10\text{mA}$	
-55°C		2.5				
		4				
On State Collector Current	$I_{C(ON)}$	1		mA	$V_{CE} = 5\text{V}, I_B = 0, I_F = 10\text{mA}$	
+100°C		2.5				
		4				
Off State Collector Current	$I_{C(OFF)}$		100	nA	$V_{CE} = 20\text{V}, I_B = 0, I_F = 0\text{mA}$	
Off State Collector Current	$I_{C(OFF)}$		100	$\mu\text{A}$	$V_{CE} = 20\text{V}, I_B = 0, I_F = 0\text{mA}$	
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$		0.3	V	$I_C = 2.5\text{mA}, I_B = 0, I_F = 20\text{mA}$	
	$V_{CE(SAT)}$		0.3	V	$I_C = 5\text{mA}, I_B = 0, I_F = 20\text{mA}$	
	$V_{CE(SAT)}$		0.3	V	$I_C = 10\text{mA}, I_B = 0, I_F = 20\text{mA}$	
Input to Output Resistance	$R_{I-O}$	$10^{11}$			$V_{IN-OUT} = 1\text{kV}$	1
Input to Output Capacitance	$C_{I-O}$		5	pF	$F = 1\text{MHz}, V_{IN-OUT} = 1\text{kV}$	1
Rise Time	$t_r$		15	$\mu\text{s}$	$V_{CC} = 10\text{V}, I_F = 10\text{mA}, R_L = 100\Omega$	
	$t_r$		15	$\mu\text{s}$		
	$t_r$		20	$\mu\text{s}$		
Fall Time	$t_f$		15	$\mu\text{s}$	$V_{CC} = 10\text{V}, I_F = 10\text{mA}, R_L = 100\Omega$	
	$t_f$		15	$\mu\text{s}$		
	$t_f$		20	$\mu\text{s}$		

**NOTES:**

- These parameters are measured between all phototransistor leads shorted together and with both input diode leads shorted together.

**RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS:**

PARAMETER	SYMBOL	MIN	MAX	UNITS
Input Current, Low Level	$I_{FL}$	0	100	$\mu$ A
Input Current, High Level	$I_{FH}$	2	10	mA
Supply Voltage	$V_{CE}$	5	10	V

**SELECTION GUIDE**

PART NUMBER	PART DESCRIPTION
JAN4N22A	4N22A Optocoupler, JAN Screening level
JAN4N23A	4N23A Optocoupler, JAN Screening level
JAN4N24A	4N24A Optocoupler, JAN Screening level
JANTX4N22A	4N22A Optocoupler, JANTX Screening level
JANTX4N23A	4N23A Optocoupler, JANTX Screening level
JANTX4N24A	4N24A Optocoupler, JANTX Screening level
JANTXV4N22A	4N22A Optocoupler, JANTXV Screening level
JANTXV4N23A	4N23A Optocoupler, JANTXV Screening level
JANTXV4N24A	4N24A Optocoupler, JANTXV Screening level

\* JEDEC registered data



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331